

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Əlyazması hüququnda

CuGaIn₂Se₅, Ga_{0.5}In_{1.5}Se₃, Cu₃SeTe və CuInZnSe₃ YARIMKEÇİRİCİLƏRİNİN QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİ

İxtisas: 2220.01 – Yarımkəçiricilər fizikası

Elmi sahəsi: Fizika

İddiaçı: **Sevinc İsmayıl qızı İbrahimova**

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim edilmiş dissertasiyanın

AVTOREFERATI

Bakı-2022

Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu “Kristalloqrafiya“ laboratoriyasında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər: Fizika elmləri doktoru, dosent
Sakin Həmid oğlu Cabarov

Rəsmi opponetlər: AMEA-nın müxbir üzvü,
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Səlimə İbrahim qızı Mehdiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Rəna Cümşüd qızı Qasımova

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Rəhim Səlim oğlu Mədətov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.14 Dissertasiya Şurası

Dissertasiya şurasının sədri:

AMEA-nın həqiqi üzvü,
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Nazim Timur oğlu Məmmədov

Dissertasiya şurasının
elmi katibi:

Fizika elmləri doktoru, dosent
Rəfiqə Zabil qızı Mehdiyeva

Elmi seminarın sədri:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, dosent
Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev